

高压MOS管8N60C*YJ8N60

产品名称	高压MOS管8N60C*YJ8N60
公司名称	深圳市扬晶微电子有限公司
价格	1.10/PCS
规格参数	品牌:扬晶 型号:YJ8N60C 电流8A:耐压600V
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道和平路368号龙胜商业大厦4层K区
联系电话	0755-28108558 18948333261

产品详情

型号：yj8n60c 封装：to-220f

描述

yj8n60c为n沟道增强型高压功率mos场效应管。该产品可广泛适用于ac-dc开关电源，dc-dc电源转换器，高压h桥pmw马达驱动。 8a,600v,rds(on)(典型值) 0.8

低电荷、低反向传输电容 开关速度快

极限值 (tc=25)

参数名称 符号 数值 单位 漏极—源极电压 v_{dss} 600 v 漏极电流 tc=25 id 8 a 栅源电压 v_{gs} ± 30 v 耗散功率 tc=25 pd 52 w 结温 t_j 150 储存温度 t_{stg} -55 ~ 150

特性参数值 (tc=25)

参数说明 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 漏源反向电压 b_vd_{ss}v_{gs}=0v, id=250 μ a 600 — — — — v 漏源截止电流 i_{dss}v_{ds}=600v, v_{gs}=0v — — — — 1.0 μ a 栅源截止电流 i_{gss} v_{gs}= ± 30v. v_{ds}=0v — — — — ± 100 na 通态电阻 r_{ds}(on) v_{gs}=10v, id=3.5a — — 0.81.2 栅-源极开启电压 v_{gs}(th) v_{ds}=v_{gs}, id = 250 μ a 2.0 — — 4.0 v 源漏二极管正向 导通电压 v_{fsd} i_s=7a, v_{gs}=0v — — — — 1.4v